

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ  
(ダーリントン接続)

2SB1034

- マイクロ・モータドライブ, ハンマー・ドライブ用
- スイッチング用
- 電力増幅用

通信工業用

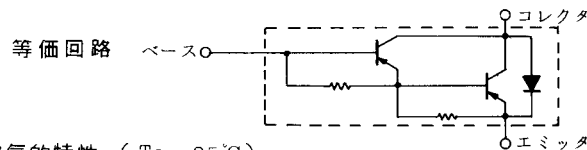
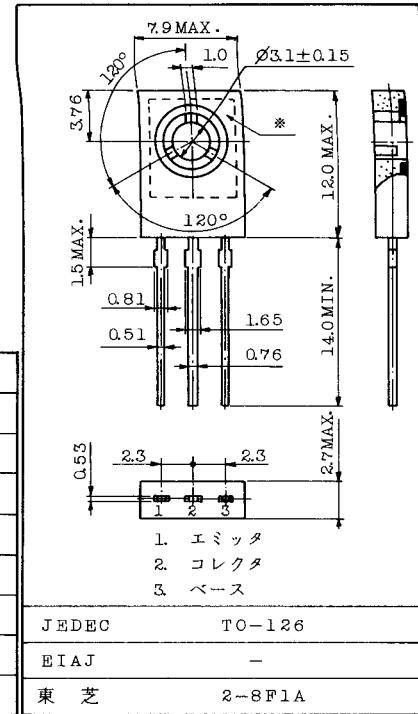
単位: mm

特 長

- ・ 直流電流増幅率が高い。  
:  $h_{FE}=2000$  (最小) ( $V_{CE}=-2V$ ,  $I_C=-1A$ )
- ・ 飽和電圧が低い。  
:  $V_{CE(sat)}=-1.5V$  (最大) ( $I_C=-1A$ ,  $I_B=-1mA$ )

最大定格 ( $T_a=25^\circ C$ )

項 目	記 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	-80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-8	V
コレクタ電流	$I_C$	-2	A
ベース電流	$I_B$	-0.5	A
コレクタ損失 ( $T_c=25^\circ C$ )	$P_C$	15	W
接 合 温 度	$T_j$	150	$^\circ C$
保 存 温 度	$T_{stg}$	-55~150	$^\circ C$



\* 点線内のメタルはコレクタに接続されています。

電気的特性 ( $T_a=25^\circ C$ )

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=-80V$ , $I_E=0$	—	—	-10	$\mu A$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=-8V$ , $I_C=0$	—	—	-4	mA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-10mA$ , $I_B=0$	-80	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE}=-2V$ , $I_C=-1A$	2000	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-1A$ , $I_B=-1mA$	—	—	-1.5	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=-1A$ , $I_B=-1mA$	—	—	-2.0	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE}=-2V$ , $I_C=-0.5A$	—	50	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=-10V$ , $I_E=0$ , $f=1MHz$	—	30	—	pF
スイッチング時間	ターンオン時間		—	0.4	—	$\mu s$
	蓄積時間		—	2.0	—	
	下降時間		—	0.4	—	